(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-192651

(P2001-192651A)

(43)公開日 平成13年7月17日(2001.7.17)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)	
C09K 11	/06 6 1 0	C 0 9 K 11/06	610 3K007	
	6 3 5		635 4C056	
	6 4 0		640 4H006	
	6 5 5		6 5 5	
C 0 7 C 15	/27	C 0 7 C 15/27		
	審査請求	: 未請求 請求項の数21 OL	(全23頁) 最終頁に続く	
(21)出願番号	特願2000-290626(P2000-290626)	(71)出願人 000005201 食士写真フィ	· ル人株子会社	
(22)出顧日	平成12年9月25日(2000.9.25)	富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地		

(31)優先権主張番号 特願平11-304206

(32)優先日

平成11年10月26日(1999.10.26)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(72)発明者 五十嵐 達也

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB18 DA02 EB00 FA00

4C056 AA01 AB01 AC02 AD03 AE03

CA04 CA24 CA28 CC01 CD01

4H006 AA01 AA03 AB92

(54) 【発明の名称】 芳香族縮環化合物、発光素子材料およびそれを使用した発光素子

(57)【要約】

【課題】 発光特性と耐久性が良好な発光素子および それを可能にする発光素子材料並びにそれを用いた発光 素子を提供する。

【解決手段】 一般式(1)で表される化合物を用い る。

【化1】

式中、Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ はアリーレン基を表 し、Ar¹², Ar²², Ar³² は置換基または水素原子 を表す。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², A r³² の少なくとも一つは縮環アリール構造または縮環 ヘテロアリール構造である。Arはアリーレン基または ヘテロアリーレン基を表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される化合物から なる発光素子材料。

1

【化1】

式中、Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ はアリーレン基を表 し、Ar¹², Ar²², Ar³² は置換基または水素原子 を表す。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², A r³² の少なくとも一つは縮環アリール構造または縮環 ヘテロアリール構造である。Arはアリーレン基または ヘテロアリーレン基を表す。

【請求項2】 下記一般式(2)で表される化合物から なる発光素子材料。

【化2】

式中、Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ はアリーレン基を表 し、A r¹², A r²², A r³² は置換基または水素原子 を表す。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², A r³² の少なくとも一つは縮環アリール構造または縮環 ヘテロアリール構造である。R1, R2, R3は水素原子 または置換基を表す。

【請求項3】 Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar 22, Ar32 の少なくとも一つがフェナントレン構造、 4環以上の縮環アリール構造または3環以上の縮環ヘテ ロアリール構造であることを特徴とする請求項1または 2に記載の発光素子材料。

【請求項4】 Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ がフェナント リレン基または4環以上の縮環アリーレン基であること を特徴とする請求項1、2または3に記載の発光素子材

【請求項5】 Ar¹², Ar²², Ar³² が縮環アリー ル基であることを特徴とする請求項1,2,3,または 4 に記載の発光素子材料。

【請求項6】 Ar¹², Ar²², Ar³² が3環以上の 縮環アリール基であることを特徴とする請求項1,2, 3, または4に記載の発光素子材料。

【請求項7】 Ar¹², Ar²², Ar³² がフェナント レン基、または4環以上の縮環アリール基であることを 特徴とする請求項1,2,3,または4に記載の発光素 子材料。

(2)

10

30

40

the effective of the first state properties of the con-

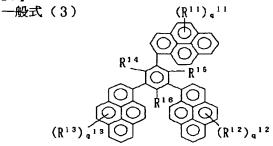
特開2001-192651

【請求項8】 炭素原子、水素原子のみから構成される ている請求項1, 2, 3, 4, 5, 6, または7に記載 の発光素子材料。

Carolinati vang Carolina Sasa

【請求項9】 一般式(3)で表される化合物。

【化3】

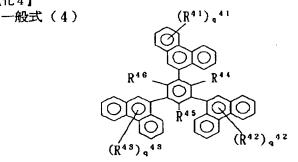


式中、R¹¹, R¹², R¹³は置換基を表す。R¹⁴、R¹⁵, R¹⁶は水素原子または置換基を表す。 q¹¹, q¹², q¹³ は0~9の整数を表す。

【請求項10】 請求項9に記載の一般式(3)で表さ れる化合物から成る発光素子材料。

20 【請求項11】 一般式(4)で表される化合物。

【化4】



式中、R⁴¹, R⁴², R⁴³は置換基を表す。R⁴⁴, R⁴⁵, R⁴⁶は水素原子または置換基を表す。 q⁴¹, q⁴², q⁴³ は0~9の整数を表す。

【請求項12】 請求項11に記載の一般式(4)で表 される化合物から成る発光素子材料。

【請求項13】 一般式(5)で表される化合物。 【化5】

一般式(5)

$$R^{56}$$
 R^{54}
 R^{52}
 R^{55}
 R^{54}
 R^{51}
 R^{51}

式中、R⁵¹は置換基を表し、R⁵⁴, R⁵⁵, R⁵⁶ は水素 原子または置換基を表す。Ar51はアンスリル基、フェ ナントリル基、または、ピレニル基を表し、Ar52はフ ェナントリル基、または、ピレニル基を表す。 q51 は 0~9の整数を表す。

50 【請求項14】 請求項13に記載の一般式(5)で表

3

される化合物から成る発光素子材料。

【請求項15】 一般式(6)で表される発光素子材 料。

【化6】

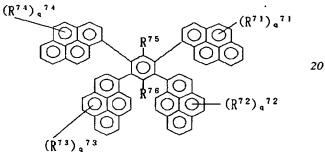
一般式 (6)

式中、R61、R62 は水素原子または置換基を表す。A r⁶¹, Ar⁶², Ar⁶³, Ar⁶⁴ は縮環アリール基を表 す。

【請求項16】 一般式(7)で表される化合物。

【化7】

一般式 (7)



一般式(8)

式中、R⁸¹, R⁸², R⁸³, R⁸⁴は置換基を表し、R⁸⁵, R⁸⁶ は水素原子または置換基を表す。 q⁸¹, q⁸², q 83, q84 は0~9の整数を表す。

【請求項19】 請求項18に記載の一般式(8)で表 される化合物から成る発光素子材料。

【請求項20】 一対の電極間に発光層もしくは発光層 を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、少なくとも一層が請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, *stc* 11 9 に記載の発光素子材料を少なくとも一種含有する層 であることを特徴とする発光素子。

【請求項21】 請求項1,2,3,4,5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, £td19 に記載の発光素子材料を含む層を塗布プロセスで成膜す ることを特徴とする請求項20に記載の有機発光素子。

*式中、R⁷¹, R⁷², R⁷³, R⁷⁴は置換基を表し、R⁷⁵. R⁷⁶ は水素原子または置換基を表す。 q⁷¹, q⁷², q 73, q74 は0~9の整数を表す。

【請求項17】 請求項16に記載の一般式(7)で表 される化合物から成る発光素子材料。

【請求項18】 一般式(8)で表される化合物。 [化8]

10

(3)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、芳香族縮環化合 物、電気エネルギーを光に変換して発光できる発光素子 40 用材料および発光素子に関し、表示素子、ディスプレ イ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、露 光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア等の分 野に好適に使用できる発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表 示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸 着により有機薄膜を形成する発光素子が知られている

(アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 91 50

5

3頁、1987年)。この文献に記載された発光素子は トリス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体 (Alq)を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料 (アミン化合物)と積層させることにより、従来の単層 型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。近 年、有機EL素子をフルカラーディスプレイへと適用す ることが活発に検討されているが、高性能フルカラーデ ィスプレイを開発する為には 青・緑・赤、それぞれの 発光素子の特性を向上する必要が有る。例えば、青色発 光素子においては、「有機EL素子とその工業化最前線」 (エヌ・ティー・エス社) p38に記載のジスチリル アリーレン化合物 (DPVBi) などが広範に検討さ れているが、色純度、耐久性、発光輝度、効率の点で問 題があり、改良が望まれていた。

【0003】有機発光素子において高輝度発光を実現し ているものは有機物質を真空蒸着によって積層している 素子であるが、製造工程の簡略化、加工性、大面積化等 の観点から塗布方式による素子作製が望ましい。しかし ながら、従来の塗布方式で作製した素子では特に青色発 光素子では、発光輝度、発光効率の点で蒸着方式で作製 した素子に劣っており、新規青色発光材料の開発が望ま れていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光 特性、耐久性が良好な発光素子およびそれを可能にする 発光素子用材料の提供にある。

[0005]

【課題を解決するための手段】この課題は下記手段によ って達成された。

[1] 下記一般式(1)で表される化合物からなる発 30 光素子材料。

[0006]

【化9】

【0007】式中、Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ はアリー レン基を表し、Ar¹², Ar²², Ar³² は置換基また は水素原子を表す。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², Ar³² の少なくとも一つは縮環アリール構造 または縮環へテロアリール構造である。Arはアリーレ ン基またはヘテロアリーレン基を表す。

[2] 下記一般式(2)で表される化合物からなる発 光素子材料。

[0008]

【化10】

【0009】式中、Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ はアリー レン基を表し、Ar¹², Ar²², Ar³² は置換基また は水素原子を表す。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², Ar³² の少なくとも一つは縮環アリール構造 または縮環へテロアリール構造である。R¹, R², R³ は水素原子または置換基を表す。

[3] Ar^{11} , Ar^{21} , Ar^{31} , Ar^{12} , Ar^{22} , A.r³² の少なくとも一つがフェナントレン構造、4環以 上の縮環アリール構造または3環以上の縮環へテロアリ ール構造であることを特徴とする[1], [2]に記載 'の発光素子材料。

[4] Ar^{11} , Ar^{21} , Ar^{31} がフェナントリレン 基または4環以上の縮環アリーレン基であることを特徴 とする[1], [2], [3]に記載の発光素子材料。 [5] Ar¹², Ar²², Ar³² が縮環アリール基で あることを特徴とする [1], [2], [3], [4] に記載の発光素子材料。

[6] Ar¹², Ar²², Ar³² が3環以上の縮環ア リール基であることを特徴とする [1], [2],

[3], [4]に記載の発光素子材料。

[7] Ar^{12} , Ar^{22} , Ar^{32} %7x+v+v基、4環以上の縮環アリール基であることを特徴とする [1], [2], [3], [4]に記載の発光素子材 料。

[8] 炭素原子、水素原子のみから構成されるている

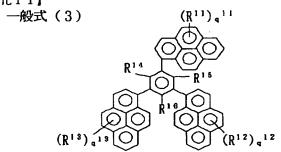
[1], [2], [3], [4], [5], [6],

[7] に記載の発光素子材料。

[9] 一般式(3)で表される化合物。

[0010]

【化11】



【0011】式中、R¹¹、R¹²、R¹³は置換基を表す。 R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶は水素原子または置換基を表す。 q¹¹, q¹², q¹³ は0~9の整数を表す。

[10] [9] に記載の一般式 (3) で表される化合 50 物から成る発光素子材料。

(5)

特開2001-192651 。

[11] 一般式(4)で表される化合物。

[0012]

【化12】

一般式(4)

(R⁴¹), ⁴¹

R⁴⁶

R⁴⁵

(R⁴³), ⁴³

【0013】式中、 R^{41} , R^{42} , R^{43} は置換基を表す。 R^{44} , R^{45} , R^{46} は水素原子または置換基を表す。 q^{41} , q^{42} , q^{43} は0~9の整数を表す。

[12] [11] に記載の一般式 (4) で表される化 合物から成る発光素子材料。

[13] 一般式(5)で表される化合物。

[0014]

【化13】

一般式(5)

$$R^{56}$$
 Ar^{51}
 R^{54}
 R^{55}
 R^{54}
 R^{51}
 R^{51}

一般式(8)

【0015】式中、 R^{51} は置換基を表し、 R^{54} , R^{55} , R^{56} は水素原子または置換基を表す。 Ar^{51} はアンスリル基、フェナントリル基、または、ピレニル基を表し、 Ar^{52} はフェナントリル基、または、ピレニル基を表す。 q^{51} は $0\sim9$ の整数を表す。

[14] [13] に記載の一般式(5) で表される化 合物から成る発光素子材料。 * [15] 一般式(6)で表される発光素子材料。

[0016]

【化14】

一般式(6)

$$Ar^{63} \xrightarrow{R^{61}} Ar^{61}$$

$$Ar^{64} \xrightarrow{R^{62}} Ar^{62}$$

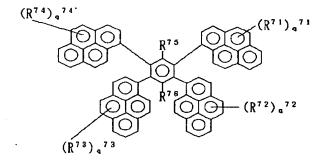
10 【0017】式中、R⁶¹, R⁶² は水素原子または置換 基を表す。Ar⁶¹, Ar⁶², Ar⁶³, Ar⁶⁴ は縮環ア リール基を表す。

[16] 一般式(7)で表される化合物。

[0018]

【化15】

一般式(7)



【0019】式中、 R^{71} , R^{72} , R^{73} , R^{74} は置換基を表し、 R^{75} , R^{76} は水素原子または置換基を表す。 q^{71} , q^{72} , q^{73} , q^{74} は $0\sim9$ の整数を表す。

) [17] [16] に記載の一般式(7)で表される化 合物から成る発光素子材料。

[18] 一般式(8)で表される化合物。

[0020]

【化16】

(R⁸⁴)_q⁸⁴

(R⁸¹)_q⁸¹

(R⁸¹)_q⁸¹

(R⁸²)_q⁸

20

【0021】式中、 R^{81} , R^{82} , R^{83} , R^{84} は置換基を表し、 R^{85} , R^{86} は水素原子または置換基を表す。 q^{81} , q^{82} , q^{83} , q^{84} は $0\sim9$ の整数を表す。

[19] [18] に記載の一般式 (8) で表される化 合物から成る発光素子材料。

[20] 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む 複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少 50 なくとも一層が [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [12], [14], [15], [17], [19] に記載の発光素子材料を少なくとも一種含有する層であることを特徴とする発光素子。

[21] [1], [2], [3], [4], [5],

[6], [7], [8], [10], [12], [1

(6)

20

and the state of the first of the extension

特開2001-192651 10

4], [15], [17], [19] に記載の発光素子 材料を含む層を塗布プロセスで成膜することを特徴とす る [20] に記載の有機発光素子。

化邻氯化物 经收益 经销售

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。

[0023] 【化17】 一般式(1) Ar12 Ār¹¹ Ar³² År

【0024】一般式(1)について説明する。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹ はアリーレン基を表す。アリーレン基 の炭素数は6~30が好ましく、6~20がより好まし く、6~16がさらに好ましい。アリーレン基として は、例えば、フェニレン基、ナフチレン基、アンスリレ ン基、フェナントレニレン基、ピレニレン基、ペリレニ レン基、フルオレニレン基、ビフェニレン基、ターフェ ニレン基、ルプレニレン基、クリセニレン基、トリフェ ニレニレン基、ベンゾアンスリレン基、ベンゾフェナン トレニレン基、ジフェニルアンスリレン基 などが挙げ られ、これらのアリーレン基はさらに置換基を有してい ても良い。

【0025】アリーレン基上の置換基としては、例え ば、アルキル基(好ましくは炭素数1~30、より好ま しくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10 であり、例えばメチル、エチル、isoープロピル、t ertーブチル、nーオクチル、nーデシル、nーヘキ サデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘ キシルなどが挙げられる。)、アルケニル基(好ましく は炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特 に好ましくは炭素数2~10であり、例えばビニル、ア リル、2-ブテニル、3-ペンテニルなどが挙げられ る。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~30、よ り好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2 ~10であり、例えばプロパルギル、3ーペンチニルな どが挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素数6 ~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましく は炭素数6~12であり、例えばフェニル、p-メチル フェニル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられ る。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~30、より好 ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭素数0~1 0 であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミ ノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルア ミノ、ジトリルアミノなどが挙げられる。)、アルコキ シ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素 数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、例

えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキシ ロキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基(好ま しくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~2 0、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニルオキシ、1-ナフチルオキシ、2-ナフチルオキシ などが挙げられる。)、ヘテロアリールオキシ基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばピリ ジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノ 10 リルオキシなどが挙げられる。)、アシル基(好ましく は炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特 【0026】に好ましくは炭素数1~12であり、例え ばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが 挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは 炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に 好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカル ボニル、エトキシカルボニルなどが挙げられる。)、ア リールオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~3 0、より好ましくは炭素数7~20、特に好ましくは炭 素数7~12であり、例えばフェニルオキシカルボニル などが挙げられる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭 素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好 ましくは炭素数2~10であり、例えばアセトキシ、ベ ンゾイルオキシなどが挙げられる。)、アシルアミノ基 (好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2 ~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えば アセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられ る。)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭 素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好 ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボ ニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシカル ボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~30、より好ま しくは炭素数7~20、特に好ましくは炭素数7~12 であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが 挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素 数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルホニル アミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられ る。)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~3 0、より好ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭 素数0~12であり、例えばスルファモイル、メチルス ルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスル ファモイルなどが挙げられる。)、カルバモイル基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカル パモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイ ル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アル キルチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられ

50

11

る。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。)、ヘテロアリールチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好

30、より好ましくは炭素数1~20、特に好 【0027】ましくは炭素数1~12であり、例えばピ リジルチオ、2-ベンズイミゾリルチオ、2-ベンズオ キサゾリルチオ、2-ベンズチアゾリルチオなどが挙げ られる。)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げ られる。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばメタンスルフィニル、ベン ゼンスルフィニルなどが挙げられる。)、ウレイド基 (好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1 ~20、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えば ウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙 げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~ 30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは 炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド、 フェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキ シ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原 子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、ス ルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸 基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環 基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数 1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原 子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリ ル、ピリジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジ ル、モルホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾ リル、ベンズチアゾリル、カルバゾリル基、アゼピニル 基などが挙げられる。)、シリル基(好ましくは炭素数 3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好まし くは炭素数3~24であり、例えばトリメチルシリル、 トリフェニルシリルなどが挙げられる。) などが挙げら れる。これらの置換基は更に置換されてもよい。

【0028】Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹は好ましくはフェニレン基、ナフチレン基、アンスリレン基、フェナントレニレン基、ピフェニレン基、4環以上のアリーレン基 (例えばピレニレン基、ペリレニレン基)、であり、より好ましくは、フェニレン基、ナフチレン基、フェナントレン基、4環以上のアリーレン基であり、さらに好ましくは、フェニレン基、フェナントリレン基、ピレニレン基であり、特に好ましくは、ピレニレン基である。

【0029】Ar¹², Ar²², Ar³² は置換基または 水素原子を表す。置換基としては、前記Ar¹¹上の置換 基で説明した基が挙げられる。Ar¹², Ar²², Ar³² として好ましくは水素原子、アリール基、ヘテロアリ ール基、アルキル基、アルケニル基であり、より好まし くは、水素原子、アリール基、ヘテロアリール基であ り、さらに好ましくは水素原子、アリール基であり、特 に好ましくは、水素原子、ピレニル基である。

12

【0030】Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², A r²², Ar³² の少なくとも一つは縮環アリール構造または縮環へテロアリール構造である。Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², Ar³² の少なくとも一つが縮環アリール構造であることが好ましい。縮環アリール構造としては、好ましくは、ナフタレン構造、アントラセン構造、フェナントレン構造、ピレン構造、アントラセン構造、より好ましくは、ナフタレン構造であり、さらに好ましくは、フェナントレン構造、4環以上のアリール構造であり、特に好ましくは、ピレン構造である。

【0031】縮環ヘテロアリール構造としては、好ましくはキノリン構造、キノキサリン構造、キナゾリン構造、アクリジン構造、フェナントリジン構造、フタラジン構造、フェナントロリン構造であり、より好ましくは、キノリン構造、キノキサリン構造、キナゾリン構20 造、フタラジン構造、フェナントロリン構造である。

【0032】Arはアリーレン基(好ましくは炭素数6 ~30、より好ましくは6~20、さらに好ましくは炭 素数6~16、例えばフェニレン基、ナフチレン基、ア ントラセニレン基、フェナントレン基、ピレニレン基、 トリフェニレン基などが挙げられる。)、ヘテロアリー レン基(ヘテロ原子として好ましくは窒素原子、硫黄原 子、酸素原子、より好ましくは窒素原子、好ましくは炭 素数2~30より好ましくは炭素数3~20、さらに好 ましくは炭素数3~16、例えばピリジレン基、ピラジ レン基、チオフェニレン基、キノリレン基、キノキサリ レン基、トリアジレン基などが挙げられる)を表し、こ れらの基は置換基を有していても良い。置換基としては 例えば、前記Ar¹¹上の置換基で説明した基が挙げられ る。Arはフェニレン基、ナフチレン基、アントラセニ レン基、ピレニレン基、トリフェニレン基であることが 好ましく、フェニレン基であることがより好ましく、無 置換 (Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹は置換されている) フェ ニレン基、アルキル置換フェニレン基であることがさら に好ましい。

【0033】一般式(1)で表される化合物の好ましい 形態は、一般式(2)で表される化合物、一般式(6) で表される化合物であり、より好ましい形態は、一般式 (3)で表される化合物、一般式(4)で表される化合 物、一般式(5)で表される化合物、一般式(7)で表 される化合物、一般式(8)で表される化合物であり、 さらに好ましい形態は一般式(3)で表される化合物で ある。また、本発明の化合物は、炭素原子、水素原子の みから構成されている化合物が好ましい。

[0034]

50 【化18】

(8)

特開2001-192651

 R^{56} R^{51} R^{54} R^{52} R^{55} R^{55} R^{51}

[0035] [化19] 一般式(3) (R¹¹)_q¹¹ R¹⁴ R¹⁵

【0038】 【化22】 10 —般式(6)

[0039]

-般式 (5)

$$Ar^{63} \xrightarrow{R^{61}} Ar^{61}$$

$$Ar^{64} \xrightarrow{R^{62}} Ar^{62}$$

[0036] [化20] 一般式(4) (R⁴¹)_q⁴¹ R⁴⁶ R⁴⁴ (R⁴³)_q⁴³ 【代23】 一般式 (7) (R⁷⁴) q⁷⁴ (R⁷⁵) q⁷⁵ (R⁷⁵) q⁷²

【0037】 【化21】

【0040】 *30 【化24】

20

【0041】一般式(2)について説明する。一般式(2)のAr¹¹,Ar²¹,Ar³¹,Ar¹²,Ar²²,Ar³² 基は一般式(1)で説明したAr¹¹,Ar²¹,Ar²¹,Ar³¹,Ar¹²,Ar²²,Ar³² 基とそれぞれ同義であり、好ましい範囲も同じである。R¹,R²,R³は水素原子または置換基を表す。置換基としては、前記Ar¹¹上の置換基で説明した基が挙げられる。R¹,R²,R³は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基である。

【0042】一般式 (1), (2) で表される化合物は Ar¹¹, Ar²¹, Ar³¹, Ar¹², Ar²², Ar³² の 50

16

Ar³¹ がフェナントリレン基または4環以上の縮環アリーレン基である化合物が好ましい。

15

【0043】一般式(1), (2)で表される化合物は、炭素原子、水素原子のみから構成されている化合物が好ましい。

【0044】一般式(3)について説明する。R¹¹,R¹²,R¹³は置換基を表す。置換基としては、前記Ar¹¹上の置換基で説明した基が挙げられる。R¹¹,R¹²,R¹³は好ましくはアルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基であり、より好ましくは、アルキル基、アリール基であり、さらに好ましくは、アリール基である。

【0045】 q^{11} , q^{12} , q^{13} は $0\sim9$ の整数を表す。 q^{11} , q^{12} , q^{13} は好ましくは $0\sim3$ の整数であり、より好ましくは $0\sim2$ の整数であり、さらに好ましくは0, 1である。

【0046】R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶ は前記R¹と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0047】一般式 (4) について説明する。 R^{41} , R^{42} , R^{43} は前記 R^{1} と同義であり、好ましい範囲も同じである。 R^{44} , R^{45} , R^{46} は前記 R^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。 q^{41} , q^{42} , q^{43} は $0\sim9$ の整数を表し、好ましくは $0\sim3$ の整数であり、より好ましくは $0\sim2$ の整数であり、さらに好ましくは0,1 である。

【0048】一般式(5)について説明する。 R^{51} は前記 R^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。 R^{54} , R^{55} , R^{56} は前記 R^{1} と同義であり、好ましい範囲も同じである。 $A r^{51}$ はアンスリル基、フェナントリル基、ピレニル基を表し、 $A r^{52}$ はフェナントリル基、ピレニル基を表す。 $A r^{51}$ はフェナントリル基、ピレニル基が好ましく、ピレニル基がより好ましい。 $A r^{52}$ はピレニル基が好ましい。 q^{51} は $0 \sim 9$ の整数を表し、好ましくは $0 \sim 3$ の整数であり、より好ましくは $0 \sim 2$ の整数であり、さらに好ましくは0, 1 である。

【0049】一般式(6) について説明する。R⁶¹, R ⁶² は前記R¹と同義であり、好ましい範囲も同じである。A r⁶¹, A r⁶², A r⁶³, A r⁶⁴ は縮環アリール

基を表し、好ましくはフェナントリル基、4環以上のアリール基であり、より好ましくは、フェナントリル基、ピレニル基である。

【0050】一般式(7)について説明する。 R^{71} , R^{72} , R^{73} , R^{74} は前記 R^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。 R^{75} , R^{76} は前記 R^{1} と同じであり、好ましい範囲も同じである。 q^{71} , q^{72} , q^{73} , q^{74} は $0\sim9$ の整数を表し、好ましくは $0\sim3$ の整数であり、より好ましくは $0\sim2$ の整数であり、さらに好ましくは0, 1である。

【0051】一般式(8)について説明する。R⁸¹, R⁸², R⁸³, R⁸⁴は前記R¹¹と同義であり、好ましい範囲も同じである。R⁸⁵, R⁸⁶ は前記R¹と同じであり、好ましい範囲も同じである。q⁸¹, q⁸², q⁸³, q⁸⁴ は0~9の整数を表し、好ましくは0~3の整数であり、より好ましくは0~2の整数であり、さらに好ましくは0、1である。

【0052】本発明の化合物は低分子化合物であっも良く、また、オリゴマー化合物、ポリマー化合物(重量平20 均分子量(ポリスチレン換算)は好ましくは1000~5000000、より好ましくは2000~1000000000、さらに好ましくは3000~100000である。)であっても良い。ポリマー化合物の場合、一般式(1)~一般式(8)で表される構造がポリマー主鎖中に含まれても良く、また、ポリマー側鎖に含まれていても良い。また、ポリマー化合物の場合、ホモポリマー化合物であっても良く、共重合体であっても良い。本発明の化合物は低分子化合物が好ましい。

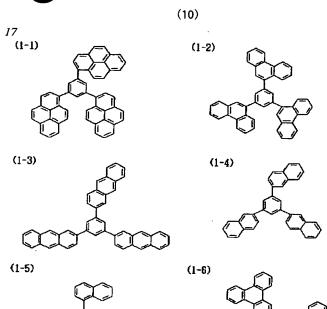
【0053】本発明の化合物は、その蛍光スペクトルの λ m a x (最大発光波長) が $400 \sim 500$ n m である ことが好ましく、 $400 \sim 480$ n m であることがより 好ましく、 $400 \sim 460$ n m であることがさらに好ましい。

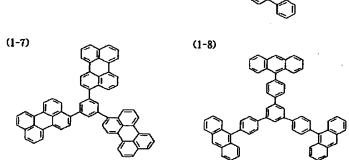
【0054】次に本発明の化合物の化合物例を示すが、 本発明はこれに限定されない。

[0055]

【化25】







[0056]



(1-10) 特開 2 0 0 1 - 1 9 2 6 5 1 20 (1-10) (1-12) (1-13) (1-14)

[0057]

(12)

特開 2 0 0 1 - 1 9 2 6 5 1 22

【0058】 【化28】 (13)

特開2001-192651

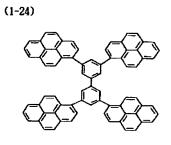
(1-21)

*【0059】 【化29】

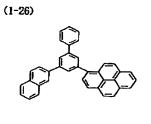
(1-22)

10

(1-23)
ボリスチレン換算分子最Mw-4200



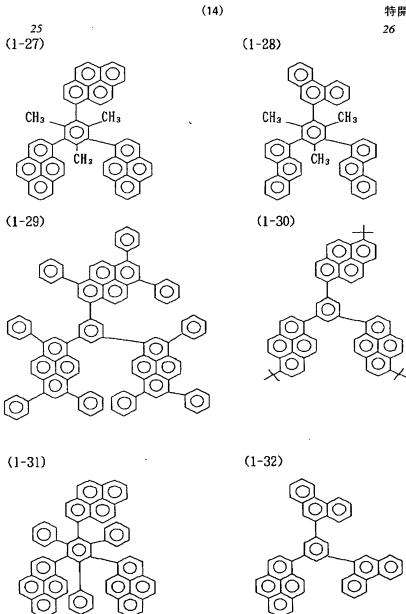
(1-25)



[0060]

【化30】





[0061]



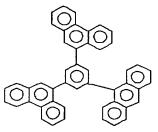
(15)

特開2001-192651

(1-33)

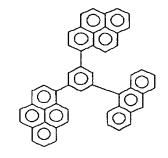


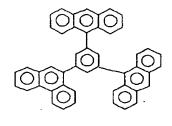




(1-35)

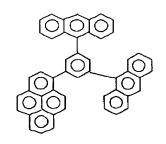
(1-36)

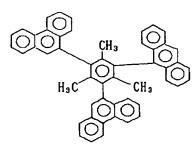




(1-37)

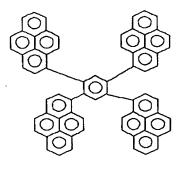
(1-38)

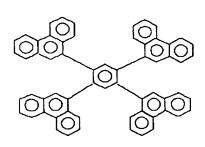




(1-39)

(1-40)





[0062]

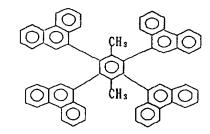
【化32】

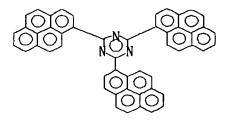
(16)

特開2001-192651 30

29 (1-41)

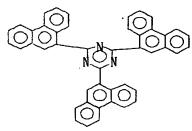
(1-42)

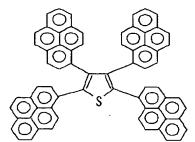




(1-43)

(1-44)





【0063】次に、本発明の化合物の製造方法について述べる。本発明の化合物は、種々の公知の芳香族炭素炭素結合生成反応を利用して合成可能であり、例えば、Organic Synthesis Reaction Guide (John Wiley & Sons, Inc.社) p. 617~p. 643、及び、Comprehensive Organic Transform ation (VCH社) p. 5~p. 103 などに記載されている手法を利用して合成することができる。パラジウム触媒存在下炭素炭素結合を生成する合成法好ましく、ホウ酸誘導体とアリールハライド誘導体をパラジウム触媒存在下合成する手法がさらに好ましい。

【0064】ホウ酸誘導体としては、置換または無置換のアリールホウ酸誘導体(例えば、1,4ーフェニルジホウ酸、4,4′ーピフェニルジホウ酸、ピレンホウ酸誘導体、フェナントレンホウ酸誘導体等が挙げられる)、ヘテロアリールホウ酸誘導体(例えばピリジルジホウ酸などが挙げられる)などが挙げられる。

【0065】アリールハライド誘導体のハロゲン原子は、好ましくは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子であり、特に好ましくは臭素原子である。

【0066】パラジウム触媒としては、特に限定しないが、例えば、パラジウムテトラキストリフェニルホスフィン、パラジウムカーボン、酢酸パラジウム、パラジウムジクロライド(dppf)(dppf:1,1'ービスジフェニルホスフィノフェロセン)などが挙げられる。トリフェニルホスフィンなどの配位子を同時に添加しても良い。

【0067】本反応は、塩基を用いたほうが好ましい。

用いる塩基の種類は特に限定しないが、例えば、炭酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、トリエチルアミンなどが挙げられる。用いる塩基の量は特に限定しないが、ホウ酸(エステル)部位に対して、好ましくは0.1~20当量、特に好ましくは1~10当量である。

【0068】本反応は溶媒を用いた方が好ましい。用いる溶媒は特に限定しないが、例えば、エタノール、水、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、トルエン、テトラヒドロフラン及びそれらの混合溶媒を用いることができる。

【0069】次に、本発明の化合物を含有する発光素子に関して説明する。本発明の発光素子は、本発明の化合物を利用する素子であればシステム、駆動方法、利用形態など特に問わないが、本発明の化合物からの発光を利用するもの、または本化合物を電荷輸送材料として利用する物が好ましい。代表的な発光素子として有機EL

(エレクトロルミネッセンス) 素子を挙げることができ 40 る。

【0070】本発明の化合物を含有する発光素子の有機層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法、インクジェット法、印刷法などの方法が用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティング法が好ましい。

【0071】本発明の発光素子は陽極、陰極の一対の電 極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄 膜を形成した素子であり、発光層のほか正孔注入層、正 孔輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有し

INCREMENTS

of the torrespond with the

31

1 1 1 1

てもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いることができる。

【0072】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層な どに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用 いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材 料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電性金 属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは50nm~1μmであり、更に好ましくは 100 nm~500 nm c a a .

【0073】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ ラスを用いる場合には、通常 0. 2 mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、酸化インジウム スズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えばITOの場 合、UVーオゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ

【0074】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層などに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いることができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばLi、Na、K等)及びそのフッ化物または酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金またはそれらの混合金属、リチウムーアルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウム

銀合金またはそれらの混合金属、インジウム、イッテ リビウム等の希土類金属等が挙げられ、好ましくは仕事 関数が4eV以下の材料であり、より好ましくはアルミ ニウム、リチウムーアルミニウム合金またはそれらの混 合金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの混合金属 等である。陰極は、上記化合物及び混合物の単層構造だ けでなく、上記化合物及び混合物を含む積層構造を取る こともできる。例えば、アルミニウム/フッ化リチウ ム、アルミニウム/酸化リチウム の積層構造が好まし い。陰極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通 10 常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好ま しくは $50nm\sim1\mu$ mであり、更に好ましくは100nm~lμmである。陰極の作製には電子ビーム法、ス パッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法など の方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成 分以上を同時に蒸着することもできる。さらに、複数の 金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能で あり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよ い。陽極及び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数 20 百Ω╱□以下が好ましい。

【0075】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよく、また、一重項励起子、または、三重項励起 子のいずれから発光する物であっても良い。例えばベン ゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベ ンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリ フェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラ フェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、ク マリン誘導体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキ サジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘 導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアント ラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘 導体、チアジアゾロピリジン誘導体、シクロペンタジエ ン誘導体、スチリルアミン誘導体、芳香族ジメチリディ ン化合物、8-キノリノール誘導体の金属錯体や希土類 錯体に代表される各種金属錯体等、ポリチオフェン、ポ リフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー化 合物、有機シラン誘導体、本発明の化合物等が挙げられ る。発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通 常1nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好まし くは $5 nm \sim 1 \mu m$ であり、更に好ましくは $10 nm \sim$ 500nmである。発光層の形成方法は、特に限定され るものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッ タリング、分子積層法、コーティング法(スピンコート 法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジェ ット法、印刷法、LB法などの方法が用いられ、好まし

50

くは抵抗加熱蒸着、コーティング法である。

【0076】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、カルバゾール誘 導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキ サジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリー ルアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導 体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ(N-ビニルカルバゾール)誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー、有機シラン誘導体、カーボン 膜、本発明の化合物等が挙げられる。正孔注入層、正孔 輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは $5 \text{ nm} \sim 1 \mu \text{ m}$ であり、更に好ましくは $10 \text{ nm} \sim 50$ 0 n m である。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材料 の1種または2種以上からなる単層構造であってもよい し、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造 であってもよい。正孔注入層、正孔輸送層の形成方法と しては、真空蒸着法やLB法、前記正孔注入輸送材料を 溶媒に溶解または分散させてコーティングする方法 (ス ピンコート法、キャスト法、ディップコート法など)、 インクジェット法、印刷法が用いられる。コーティング 法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することがで き、樹脂成分としては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカ ーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレー ト、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリス ルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、ポ リ(Nーピニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロー ス、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン 樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキ シ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0077】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているものであればよい。その具体例としては、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8ーキノ

リノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベ ンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金 属錯体に代表される各種金属錯体、有機シラン誘導体、 本発明の化合物等が挙げられる。電子注入層、電子輸送 層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1nm ~5 µ mの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 n $m\sim 1 \mu m$ であり、更に好ましくは $10 nm\sim 500 n$ mである。電子注入層、電子輸送層は上述した材料の1 種または2種以上からなる単層構造であってもよいし、 同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造であ ってもよい。電子注入層、電子輸送層の形成方法として は、真空蒸着法やLB法、前記電子注入輸送材料を溶媒 に溶解または分散させてコーティングする方法(スピン コート法、キャスト法、ディップコート法など)、イン クジェット法、印刷法などが用いられる。コーティング 法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することがで き、樹脂成分としては例えば、正孔注入輸送層の場合に 例示したものが適用できる。

【0078】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 20 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, N i 等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2O3、G eO、NiO、CaO、BaO、Fe2O3、Y2O3、T i O2等の金属酸化物、MgF2、LiF、AlF3、C a F2等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレ ア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフル オロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロ ロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレン との共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1 種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて 得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フ ッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率 0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護層の形 成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、 スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE (分子線エピタキシ) 法、クラスターイオンビーム法、 イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起 イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザ -CVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーテ ィング法、印刷法を適用できる。

[0079]

【実施例】以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本 発明の実施の態様はこれらに限定されない。

(1-1) の合成

ピレンホウ酸エステル a 1.0 g、1,3,5-トリプロモベンゼン 0.29g、炭酸ナトリウム 0.6 g、トリフェニルホスフィン 0.05g、パラジウムカーボン 0.05gにジエチレングリコールジメチル

36

エーテル 20ml、水 20ml を加え還流攪拌した。6時間後、反応溶液をクロロホルム200ml、水200mlで希釈し、セライトろ過した。有機層を水100mlで2回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を濃縮した。カラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製した後、再結晶で精製し(クロロホルム/メタノール)(1-1) 0.5g を得た。(1-10の合成

35

*1) の蒸着膜を作製し、その膜蛍光を測定したところ、 膜蛍光極大波長 λ m a x は 4 8 0 n m であった。化合 物のガラス転移点 (Tg) を測定したところ、1 6 4 ℃ であった。

【0080】 【化33】

[0082]

【0081】 (1-2) の合成

フェナントレンホウ酸エステル 1.5 g、1,3,5 ートリプロモベンゼン0.47g、炭酸ナトリウム 1.6g、トリフェニルホスフィン 0.07g、パラジウムカーボン 0.07gにジエチレングリコールジメチルエーテル 30ml、水 30ml を加え還流攪拌した。6時間後、反応溶液をクロロホルム200ml、一規定塩酸水200mlで希釈し、セライトろ過した。有機層を水100mlで2回洗浄し、硫酸ナトリウ※

※ムで乾燥した後、溶媒を濃縮した。カラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル系)で精製した後、再結
20 晶で精製し(クロロホルム/メタノール) (1-2)
1.0gを得た。MSスペクトルを測定し、(1-2)の構造を確認した。(1-2)の蒸着膜を作製し、その膜蛍光を測定したところ、膜蛍光極大波長λmaxは380nmであった。

2回洗浄し、硫酸ナトリウ※ 【化34】
Br

Br

Pd-C. PPh₃. Na₂CO₃

MeO~O~OMe

水、 還流

【0083】(1-39)の合成

ピレンホウ酸エステル 1.0 g、1,2,4,5-テトラブロモベンゼン0.28g、炭酸ナトリウム 0.88g、トリフェニルホスフィン 0.05g、パラジウムカーボン 0.05gにジエチレングリコールジメチルエーテル 30ml、水 30ml を加え還流攪拌した。6時間後、反応溶液をクロロホルム200ml、一規定塩酸水200mlで希釈し、セライトろ過した。★

★有機層を水100mlで2回洗浄し、硫酸ナトリウムで 乾燥した後、溶媒を濃縮した。カラムクロマトグラフィ ー (クロロホルム) で精製した後、再結晶で精製し (ク ロロホルム/メタノール) (1-39) 0.4g を 得た。MS スペクトルを測定し (1-39) の構造を 確認した。

[0084]

【 0 0 8 5】 (1 - 4 0)の合成 4, 5 - テトラブロモベンゼン 0. 3 5 g、炭酸ナトフェナントレンホウ酸エステル 1. 1 5 g、1, 2, 50 リウム 0. 9 6 g、トリフェニルホスフィン 0. 0 7

*3*8

g、パラジウムカーボン 0.07gにジエチレングリコールジメチルエーテル 30ml、水 30ml を加え還流攪拌した。6時間後、室温に冷却し、セライトろ過した。ろ別した固体をクロロホルムに溶解し、セライトろ過し、パラジウムカーボンを除去した。カラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製した後、再結晶で精製し(クロロホルム/メタノール) (1-40)

37

*0.5 g を得た。MSスペクトル測定により(1-40)の構造を確認した。(1-40)の蒸着膜を作製し、その膜蛍光を測定したところ、膜蛍光極大波長 λ m a x は 440 n m であった。

【0086】 【化36】

【0087】 (1-35) の合成

1, 3, 5-トリプロモベンゼン25gにジエチルエーテル250mlを加え、窒素気流下 -78℃に冷却した。n-プチルリチウム(1.6M ヘキサン溶液)52mlを滴下し、室温に昇温した。アンスロン15.4gを分割添加し、加熱還流下3時間攪拌した。室温に冷却した溶液に酢酸エチル500ml、一規定塩酸水300mlを加え、有機層を分取した。有機層を飽和食塩水300mlで洗浄した後、濃縮した。カラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し中間体 A 1.5gを得た。ピレンホウ酸エステル 0.84g、化合物A0.5g、炭酸ナトリウム 0.51g、トリフェニル※

※ホスフィン 0.05g、パラジウムカーボン 0.05gにジエチレングリコールジメチルエーテル 30m 1、水 30m1を加え還流攪拌した。6時間後、室温に冷却し、セライトろ過した。ろ別した固体をクロロホルムに溶解し、セライトろ過し、パラジウムカーボンを除去した。カラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製した後、再結晶で精製し(クロロホルム/メタノール) (1-35) 0.3gを得た。MSスペクトル測定により(1-35)の構造を確認した。

【0088】 【化37】

【0089】 (1-37) の合成

1, 3, 5-トリプロモベンゼン10gにジエチルエーテル150mlを加え、窒素気流下 -78℃に冷却した。n-プチルリチウム(1.6M ヘキサン溶液)4
1.7mlを滴下し、室温に昇温した。アンスロン1
3.0gを分割添加し、加熱澄流下3時間攪拌した。ジエチルエーテルを蒸留除去し、トルエン200ml、パラトルエンスルホン酸0.1gを加え加熱澄流下3時

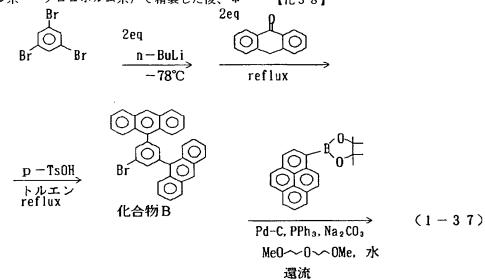
間攪拌した。室温に冷却した溶液にクロロホルム 300 ml、水300 mlを加え、有機層を分取、濃縮した。カラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製した後、晶析し(クロロホルム/ヘキサン)、中間体 B 2.0 gを得た。ピレンホウ酸エステル 0.27 g、化合物 B 0.4 g、炭酸ナトリウム 0.17 g、トリフェニルホスフィン 0.05 g、パラジウムカーボン 0.05 gにジエチレングリコールジメチルエーテル

40

30ml、水 30ml を加え還流攪拌した。6時間後、室温に冷却し、セライトろ過した。ろ別した固体をクロロホルムに溶解し、セライトろ過し、パラジウムカーボンを除去した。カラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル系 → クロロホルム系)で精製した後、*

39

え還流攪拌した。6時間 *再結晶で精製し(クロロホルム/メタノール) (1- ろ過した。ろ別した固体を 37) 0.1g を得た。MSスペクトル測定により イトろ過し、パラジウムカ (1-37) の構造を確認した。 ロマトグラフィー(ヘキサ 【0090】 ホルム系)で精製した後、* 【化38】

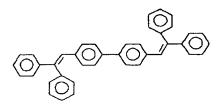


【0091】比較例1

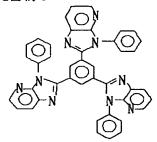
て、直流定電圧をEL素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM-8、発光波長を浜松フォトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定した。その結果、色度値(0.15,0.20)の青緑色発光が得られ、最高輝度1130cd/m²の輝度が得られた。窒素雰囲気下1日放置したところ、膜面の白濁が観察された。

30 [0092] [化39]

41 化合物 b

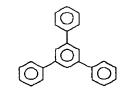


化合物c



42

化合物 d



化合物e



も有機膜は透明であった。

化合物 f

【0093】比較例2

化合物 b の替わりに化合物 d を用い、比較例 1 と同様に素子作製した。有機薄膜が白濁し、素子評価不可であった。

比較例3

化合物 b の替わりに化合物 e を用い、比較例 1 と同様に素子作製した。有機膜が白濁し、素子評価不可であった。

【0094】 実施例1

化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-1)を用い、比較例1と同様に素子作製評価した。その結果、(0.17,0.31)の青緑色発光を得、最高輝度12740 c d / m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

実施例2

化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-8)を用い、比較例 1 と同様に素子作製評価した。その結果、(0.16,0.20)の青緑色発光を得、最高輝度6110 c d / m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

実施例3

洗浄した I T O 基板を蒸着装置に入れ、 α - N P D (N, N' - ジフェニル- N, N' - ジ (α - ナフチル) - ベンジジン) を 4 0 n m蒸着し、この上に、ジスチリル化合物 b と本発明の化合物 (1-1) を 2 0 n m共蒸着し(ジスチリル化合物 b: (1-1) = 5 0:

1)、この上にアゾール化合物 c を 40 n m 蒸着した。比較例1と同様に金属蒸着評価した。その結果、(0.16,0.20)の青緑色発光を得、最高輝度11900 c d/m²を得た。窒素雰囲気下1日放置して

30 実施例4

ポリ (N-ビニルカルバゾール) 40 mg、PBD (p-t-ブチルフェニルーピフェニルー1, 2, 4, -オキサジアゾール) 12 mg、本発明の化合物 (1-21) 1 mgをジクロロエタン3 mlに溶解し、洗浄した基板上にスピンコートした(2000 rpm, 5 sec)。比較例1と同様に陰極を蒸着、評価したところ、(0.17,0.20)の青緑色発光を得、最高輝度2710 cd/m²が得られた。

実施例 5

40 化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-27)を用い、比較例1と同様に素子作製評価した。その結果、(0.16,0.22)の青色発光を得、最高輝度6170cd/m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

【0095】 実施例 6

化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-40)を用い、比較例 1 と同様に素子作製評価した。その結果、(0.18,0.18)の青色発光を得、最高輝度7550 c d/m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

50

44

洗浄したΙΤΟ基板を蒸着装置に入れ、α-ΝΡD

実施例7

化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-35)を用い、比較例1と同様に素子作製評価した。その結果、(0.20,0.28)の青緑色発光を得、最高輝度3980cd/m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

43

実施例8

化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-34)を用い、比較例 1 と同様に素子作製評価した。その結果、(0.19,0.22)の青色発光を得、最高輝度2710 c d/m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

実施例9

化合物 b の替わりに、本発明の化合物(1-40)を用い、比較例1と同様に素子作製評価した。その結果、(0.18,0.18)の青色発光を得、最高輝度3240 c d / m²を得た。窒素雰囲気下1日放置しても有機膜は透明であった。

/I. A #/. 1

実施例10

 $(N, N' - ij 7 x = n - N, N' - ij (\alpha - t 7 f n) - i (\alpha - t 1 n)$

[0096]

【発明の効果】本発明の化合物は有機EL用材料として使用可能であり、また、本発明の化合物は医療用途、蛍光増白剤、写真用材料、UV吸収材料、レーザー色素、カラーフィルター用染料、色変換フィルター等にも適用可能である。

フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 7 C 15/38		C 0 7 C 15/38	
C 0 7 D 251/24		C 0 7 D 251/24	
263/62		263/62	
333/08		333/08	
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	В

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.